



新闻动态

- ▷ 图片新闻
- ▷ 头条新闻
- ▷ 综合新闻
- ▷ 学术活动
- ▷ 科研动态
- ▷ 通知公告
- ▷ 业内信息
- ▷ 合作交流

现在位置: 首页 > 新闻动态 > 综合新闻

CEA-LETI 硅技术器件研究中心的首席科学家Simon Deleonibus博士来微电子所做学术交流

2012-04-06 | 编辑: 三室 张康玮 | 【大 中 小】 【打印】 【关闭】

3月30号, CEA-LETI 硅技术器件研究中心的首席科学家Simon Deleonibus博士到中科院微电子所进行学术交流, 并做了题为“Prospects for Nanoelectronics CMOS Scaling and Functional Diversification”的学术报告。微电子所三室主任刘明研究员主持交流会并致欢迎词, 微电子所30余名科研人员及研究生参加了交流会。

Simon Deleonibus博士从机构设置、使命焦点、研究队伍、学科建设能力等方面系统的介绍了CEA-LETI硅技术器件研究中心概况, 并对研究中心在微纳技术、生物技术、新能源技术三个研究方向做了详细论述。报告中, 他纳米电子学的热点问题和趋势、纳米电子学缩小对摩尔定律的挑战等前沿方面问题出了三维集成、功能多样化以及建构新系统减小功耗等研究。报告后, 与会听众与Simon Deleonibus博士就器件三维集成、异质结构、低功耗等行业关注的技术问题进行了热烈的学术讨论。

Simon Deleonibus博士分别在1979年和1982年从巴黎大学获得应用物理学硕士和博士学位。作为CMOS和快闪存储器应用方面器件工程的专家, 1986年加入CEA - LETI。加入CEA-LETI以来主持过终极CMOS项目, 并担任电子纳米器件实验室主任。已发表超过600篇论文, 并拥有32项专利, 并曾获得很多奖项和荣誉, 包括被选为IEEE院士及IEEE杰出讲师, 是IEEE TED (IEEE Transactions on Electron Devices)等知名期刊的编辑。他明的接触插头原理, 是半导体产业中一个在互连过程中广泛使用的标准。在1999年6月, Simon Deleonibus博士和他的团队实现了第一个20nm的栅极长度的MOSFET器件, 这曾是世界上最小的晶体管。



附件下载:



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编: 100029

单位地址: 北京市朝阳区北土城西路3号, 电子邮件: webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号